



# 九州シンクロトロン光研究センター 県有ビームライン利用報告書

課題番号： : 2205041S

BL番号： BL09

(様式第 5 号)

X線トポグラフィーによる 新規の(011)面方位 HVPE 酸化ガリウム  
エピタキシャル層の観察—従来の(001)面、(010)面方位との比較

Observation of dislocations in HVPE novel (011) surface orientation gallium oxide epitaxial layer by X-ray topography in comparison with conventional (001) and (010) surface orientation

嘉数 誠, Sdoeung Sayleap  
大坪 優斗

Makoto Kasu, Sdoeung Sayleap,  
Yuto Otsubo

佐賀大学大学院 理工学研究科  
Graduate School of Engineering, Saga University

- ※ 1 先端創生利用（長期タイプ）課題は、実施課題名の末尾に期を表す（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）を追記してください。
- ※ 2 利用情報の公開が必要な課題は、本利用報告書とは別に利用年度終了後 2 年以内に研究成果公開（論文（査読付）の発表又は研究センターの研究成果公報で公表）が必要です（トライアル利用を除く）。
- ※ 3 実験に参加された機関を全てご記載ください。
- ※ 4 共著者には実験参加者をご記載ください（各実験参加機関より 1 人以上）。

## 1. 概要（注：結論を含めて下さい）

酸化ガリウムは広いバンドギャップ、高い絶縁破壊電界や優れた熱伝導率などから次世代のパワーデバイス材料として期待されている。しかし、半導体デバイスの下地となる単結晶基板中の格子欠陥（結晶欠陥）は、素子特性に影響を与えるため課題である。

我々はこれまでに X線トポグラフィーによりダイヤモンド単結晶[1,2]や Edge defined Film fed Growth 法(EFG)や Vertical Bridgeman (VB)法[4]で育成した  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 単結晶、Halide Vapor Phase Epitaxy (HVPE)法で成長した  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> エピ膜で転位や積層欠陥の観察と同定を行ってきました。EFG 法や VB 法は  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> のウェハ（基板）結晶用であり、HVPE 法によるエピ膜は、大電力回路で応用される縦型ショットキーバリアダイオード(SBD)のドリフト層となるため特に重要です。

これまでの研究のほとんどは、(010)面方位や(001)面方位に関して調べられてきましたが、今回(011)面方位を XRT 観察します。

### (English)

Gallium oxide is wide band gap semiconductor, and are expected as high-efficient high-power electronics device. However, defects in crystals lead to a leakage current and decrease the breakdown voltage.

It has been reported that dislocations in  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> cause leakage current by Schottky diode. Therefore, to minimize the defect density, it is critical to understand crystal defects such as dislocations and stacking faults. Recently we obtained high-quality HVPE-grown  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. So far, the surface orientations of most of all studies were (010) and (001).

In this study, we observed (011)-surface oriented epilayers HVPE-grown  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

## 2. 背景と目的

我々はこれまで新しい電子材料の創製とそれを生かしたデバイス応用に関する研究を行ってきた。現在は、シリコンカーバイド(SiC), 窒化ガリウム(GaN), 窒化アルミニウム(AlN), ダイヤモンド,  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 等の広いバンドギャップをもつ新しい半導体の創製とそれをを用いた低損失・高耐圧のパワーデバイスの応用に関する研究を行っている。

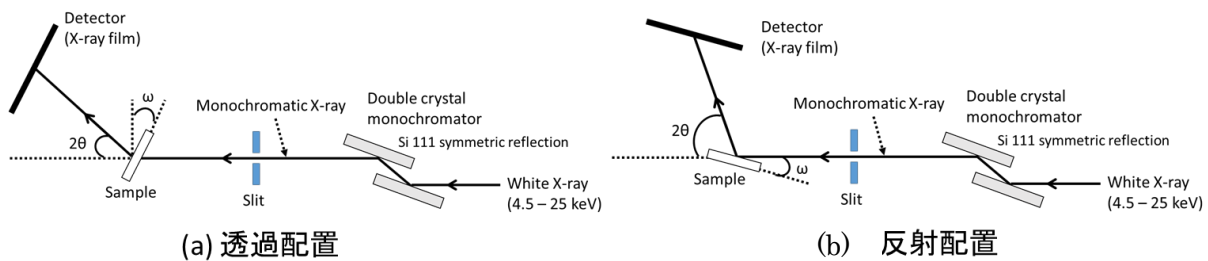
環境・エネルギー問題は、今や不可避の深刻な社会問題である。エレクトロニクス, 情報通信ネットワーク, 電力ネットワークのエネルギー効率, システムのハードウェアの大部分を占めるシリコン(Si)材料の固有の物性限界に到達している。それを打破するために, Si よりバンドギャップが広い SiC や GaN や, 新しいワイドギャップ半導体であるダイヤモンドや酸化ガリウムを用いた高効率パワーデバイスの実用化に繋げ, エネルギー問題を根本的に解決することが最大の目標である。しかしながら, 半導体結晶を用いて作製される電子デバイス・光デバイスの特性は, その結晶中の格子欠陥の物性に大きく左右される。例えば, 線状欠陥である転位は格子歪, 欠陥準位, 局所反応サイトなどを与え, 多くの場合, デバイス特性を悪化させる要因となる。そのため結晶欠陥の観察や評価は, 産業応用に向けた重要な課題である。我々はこれまでに X 線トポグラフィー測定によりダイヤモンド単結晶や  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 単結晶の転位や積層欠陥の観察と同定を行ってきた。 $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> に関しては, これまで反射トポによる表面近傍の観察を行い, 二次元像として欠陥の観察を行ってきた。しかし, これらの欠陥が実際に電子デバイスに与える影響はわかっていない。そのため,  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 半導体の素子特性向上のために, キラー欠陥となるものを理解しておく必要がある。

これまでの研究のほとんどは, (010)面方位や(001)面方位に関して調べられてきたが, 今回(011)面方位を XRT 観察する。

## 3. 実験内容 (試料, 実験方法, 解析方法の説明)

HVPE成長  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>エピ薄膜結晶で (011)面方位の試料を用意した。gベクトルは出来るだけ多くのパターンで測定し, 得られたトポグラフ像を比較し, 欠陥コントラストの消滅則により, 転位のバーガズベクトルを同定する。

測定条件 (X 線エネルギー, 試料配置など) は測定試料の面方位, 観察範囲 (表面からの深さ) によって変更するが, ブラッグ条件に当てはめ条件を決定する。



## 4. 実験結果と考察

今回(011)面方位 HVPE 成長  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> エピ薄膜結晶をシンクロトロン X 線トポグラフィー観察した。現在, 転位の種類や特性について調査中である。

## 5. 今後の課題

今回(011)面方位の HVPE  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> エピ薄膜結晶をシンクロトロン X 線トポグラフィー観察した。現在, バーガズベクトルの解析を行っている。X 線トポグラフィーや AFM や断面 TEM などを活用して欠陥の分布や種類の傾向についてより詳しく調べる。

## 6. 参考文献

- [1] M. Kasu, *et al.*, Japanese Journal of Applied Physics 55, 1202BB (2016).
- [2] O. Ueda, *et al.*, Japanese Journal of Applied Physics 55, 1202BD (2016).
- [3] H. Yamaguchi, *et al.*, Superlattices and Microstructures 99, 99 (2016).

7. 論文発表・特許 (注: 本課題に関連するこれまでの代表的な成果)

- [1] M. Kasu, R. Murakami, S. Masuya, K. Harada, and H. Sumiya, Synchrotron X-ray topography of dislocations in high-pressure high-temperature-grown single-crystal diamond with low dislocation density, *Applied Physics Express*, **7** (2014)125501.
- [2] S. Masuya, K. Hanada, T. Uematsu, T. Moribayashi, H. Sumiya, M. Kasu, Determination of the type of stacking faults in single-crystal high-purity diamond with a low dislocation density of  $<50\text{cm}^{-2}$  by synchrotron X-ray topography, *Japanese Journal of Applied Physics* **55**, (2016)040303
- [3] S. Masuya, K. Hanada, T. Moribayashi, H. Sumiya, M. Kasu, Determination of partial dislocations of stacking fault in (111) single crystal diamond grown on (111) seed crystal by synchrotron X-ray topography, *Journal of Crystal Growth*, **468** (2017) 439.
- [4] S. Masuya, K. Hanada, T. Oshima, H. Sumiya, M. Kasu, "Formation of stacking fault and dislocation behavior during the high-temperature annealing of single crystal HPHT diamond", *Diamond and Related Materials* **75** (2017) 155.
- [5] S. Sdoeung, K. Sasaki, K. Kawasaki, J. Hirabayashi, A. Kuramata, T. Oishi, and M. Kasu, "Origin of reverse leakage current path in edge-defined film-fed growth (001)  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Schottky barrier diodes observed by high-sensitive emission microscopy", *Applied Physics Letters* **117**, 022106 (2020).
- [6] S. Sdoeung, K. Sasaki, K. Kawasaki, J. Hirabayashi, A. Kuramata, and M. Kasu, "Polycrystalline defects—origin of leakage current—in halide vapor phase epitaxial (001)  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Schottky barrier diodes identified via ultrahigh sensitive emission microscopy and synchrotron X-ray topography", *Applied Physics Express* **14**, 036502 (2021).
- [7] S. Sdoeung, K. Sasaki, S. Masuya, K. Kawasaki, J. Hirabayashi, A. Kuramata, and M. Kasu, "Stacking faults: Origin of leakage current in halide vapor phase epitaxial (001)  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Schottky barrier diodes", *Appl. Phys. Lett.* **118**, 172106 (2021)

8. キーワード (注: 試料及び実験方法を特定する用語を2~3)

$\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiC, X線トポグラフィ

9. 研究成果公開について (注: ※2に記載した研究成果の公開について①と②のうち該当しない方を消してください。また、論文(査読付)発表と研究センターへの報告、または研究成果公報への原稿提出時期を記入してください(2018年度実施課題は2020年度末が期限となります)。長期タイプ課題は、ご利用の最終期の利用報告書にご記入ください。

① 論文(査読付)発表の報告 (報告時期: 2023年 3月)